

عنوان مقاله:

شناسایی یک نقص کمپلکس ذاتی در نیمرسانای GaNP

محل انتشار:

کنفرانس فیزیک ایران 1385 (سال: 1385)

تعداد صفحات اصل مقاله: 4

نویسندگان:

مرتضی ایزدی فرد - دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود

ایرینا بایانوا - دانشکده فیزیک و سنجش اندازه گیری، دانشگاه لنینکوشویپینگ، سوئد

خلاصه مقاله:

این مقاله به کمک بررسی طیف های حاصل از آزمایش تشدید مقناطیسی آشکار شده بروش اپتیکی روی نمونه های نیمرسانای سه تایی $GaN_{1-x}P_x$ با غلظت نیتروژن در محدوده $0.009 \leq x \leq 0.031$ که بروش رو آراستی پرتو - ملکولی رشد داده شده اند، یک نقص کمپلکس ذاتی وابسته به اتمهای نیتروژن و فسفر، مورد شناسایی قرار گرفته است. این نقص بلوری یک ساختار فوق ریز ناشی از برهم کنش قوی با اسپین هسته یک اتم فسفر $I=1/2$ و همچنین اسپین هسته یک اتم نیتروژن $I=1$ را نشان می دهد. طیف ثبت شده وابسته به این نقص ایزوتروپیک بوده که نشان می دهد حالت نقص بلوری وابسته دارای تقارن A_1 است. بررسی شدت طیف وابسته به این نقص نشان می دهد که امکان تشکیل و ایجاد این نقص با افزایش غلظت نیتروژن در نمونه مورد مطالعه افزایش می یابد.

کلمات کلیدی:

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/24743>

